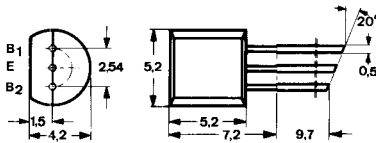


## Silizium-Unijunction-Transistor Silicon Unijunction Transistor

**Anwendungen:** Ansteuerung von Thyristoren

**Applications:** Thyristor control

**Abmessungen in mm**  
**Dimensions in mm**



Normgehäuse  
Case  
10 B 3 DIN 41 868  
JEDEC TO 92  
Gewicht · Weight  
max. 0,4 g

### Absolute Grenzwerte Absolute maximum ratings

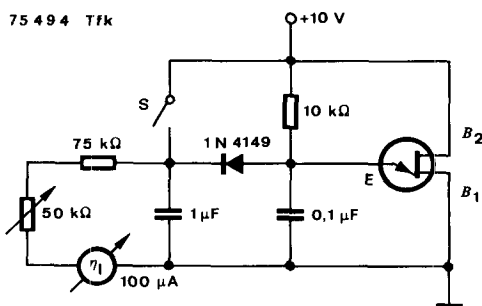
Interbasisspannung <i>Interbase voltage</i>	$U_{B1B2}^{1)}$	35	V
Emitter-Basis-1-Sperrspannung <i>Emitter-base-one voltage</i>	$-U_{EB1}$	35	V
Emitterstoßstrom <i>Emitter-surge current</i>	$I_{ESM}$	1,5	A
Gesamtverlustleistung <i>Total power dissipation</i> $t_{amb} \leq 25^{\circ}C$	$P_{tot}$	300	mW
Sperrschichttemperatur <i>Junction temperature</i>	$t_j$	125	$^{\circ}C$
Lagerungstemperaturbereich <i>Storage temperature range</i>	$t_{stg}$	-55 ... +125	$^{\circ}C$

<sup>1)</sup>  $U_{B2B1} = \sqrt{r_{BB} \cdot P_{tot}}$

# BSV 57 B

## Kenngrößen Characteristics

	Min.	Typ.	Max.
$t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$			
Emittersperrstrom Emitter cut-off current $-U_{EB1} = 30\text{ V}$	$-I_{EB10}^{*)}$		20 nA
Emitter-Sättigungsspannung Emitter saturation voltage $U_{B2B1} = 10\text{ V}, I_E = 50\text{ mA}$	$U_{EB1sat}$	2	3 V
Höckerstrom Peak point current $U_{B2B1} = 25$	$I_P$		6 $\mu\text{A}$
Talstrom Valley point current $U_{B2B1} = 20\text{ V}, R_{B2} = 100\ \Omega$	$I_V$	4	mA
Interbasiswiderstand Interbase resistance $U_{B2B1} = 3\text{ V}, I_E = 0$	$r_{BB}^{*)}$	4,7	9,1 k $\Omega$
Inneres Spannungsverhältnis Intrinsic stand-off ratio $U_{B2B1} = 10\text{ V}$	$\eta_i^{*)})$	0,68	0,82



Eichen: S-gedrückt  
Calibration with  
S-pressed

Meßschaltung für:  
Test circuit for:  $\eta_i$

\*) AQL = 0,65%,  $1) \frac{t_p}{T} = 0,01, t_p = 0,3\text{ ms}$